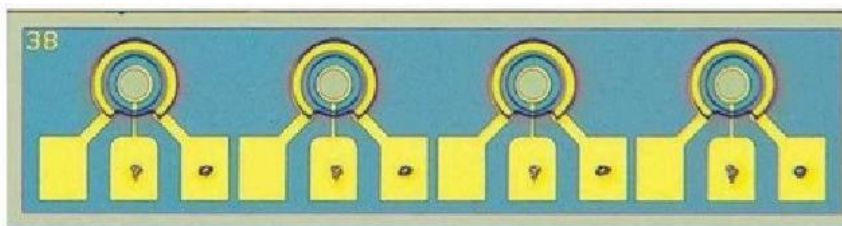


850nm 28Gbaud GaAs 1x4 Array PD Chip $\phi 38\mu\text{m}$



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器阵列芯片

产品特点

带宽高达 28GHz/通道; $\phi 38\mu\text{m}$ 有效面积; 850nm 高响应度; 正面阳极/阴极焊盘

应用领域

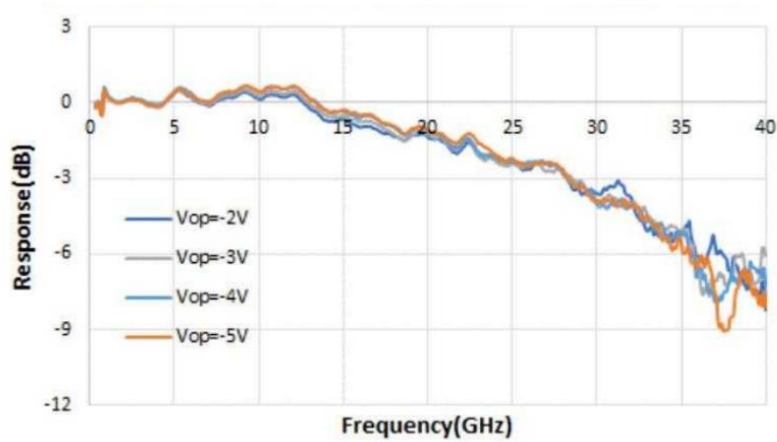
50/200Gbps PAM4 | 112G SR4AOC 接收机 | 4×25Gbps 光纤通道 | 短距离光网络

核心参数

| |
|---|
| 无 |
| 无 |



详细参数



规格 ($T_c=25^{\circ}C$, 单颗裸芯片)

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|------------------|-----------|------|------|------|-----|--------------------------------------|
| 响应范围 | λ | | 850 | 860 | nm | |
| 响应度 | R | 0.55 | 0.6 | | A/W | $\lambda=850nm$ |
| 暗电流 | I_D | | 0.01 | 0.05 | nA | $V_R=-5V$ |
| 电容 | C | | 0.07 | 0.10 | pF | $V_R=-2V, f=1MHz$ |
| 带宽 | Bw | | 28 | | GHz | $V_R=-2V$ 3dB down, $RL=50\Omega$ |
| 有效区直径 | D | | 38 | | um | |
| 通道之间的中心间距(pitch) | | | 250 | | um | |